

D25XB

800V 25A

### 特長

- 薄型 SIP パッケージ
- UL E142422
- 大電流容量
- 高耐圧・高  $I_{FSM}$
- 高放熱伝導性

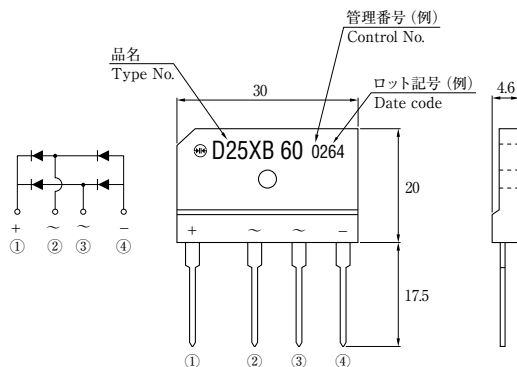
### Feature

- Thin-SIP
- UL E142422
- Large  $I_o$
- High Voltage・Large  $I_{FSM}$
- High Thermal Radiation

### ■外観図 OUTLINE

Package : 5S

Unit : mm  
Weight : 7.1g (typ.)



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

### ■定格表 RATINGS

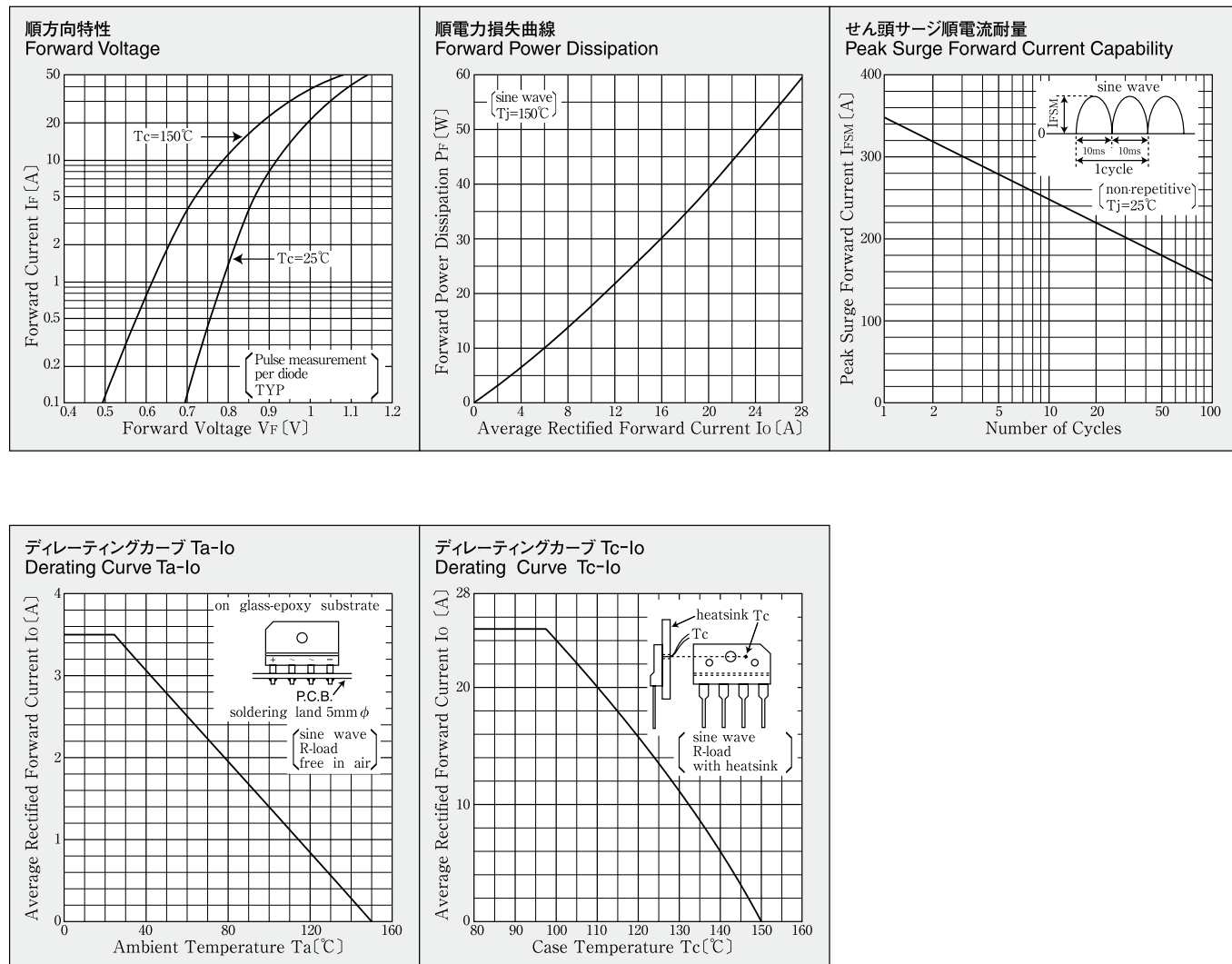
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

| 項 目<br>Item                               | 記号<br>Symbol     | 条 件<br>Conditions                                                                                                          |                           | 品 名<br>Type No.      | D25XB20  | D25XB60 | D25XB80 | 単位<br>Unit       |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|---------|---------|------------------|
| 保存温度<br>Storage Temperature               | T <sub>stg</sub> |                                                                                                                            |                           |                      | - 40~150 |         |         | ℃                |
| 接合部温度<br>Operation Junction Temperature   | T <sub>j</sub>   |                                                                                                                            |                           |                      | 150      |         |         | ℃                |
| せん頭逆電圧<br>Maximum Reverse Voltage         | V <sub>RM</sub>  |                                                                                                                            |                           |                      | 200      | 600     | 800     | V                |
| 出力電流<br>Average Rectified Forward Current | I <sub>O</sub>   | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷<br>50Hz sine wave, Resistance load                                                                          | フィン付き<br>With heatsink    | T <sub>c</sub> = 98℃ | 25       |         |         | A                |
|                                           |                  |                                                                                                                            | フィンなし<br>Without heatsink | T <sub>a</sub> = 25℃ | 3.5      |         |         |                  |
| せん頭サージ順電流<br>Peak Surge Forward Current   | I <sub>FSM</sub> | 50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> = 25℃<br>50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T <sub>j</sub> = 25℃ |                           |                      | 350      |         |         | A                |
| 電流二乗時間積<br>Current Squared Time           | I <sup>2</sup> t | 1ms≦t<10ms, T <sub>j</sub> = 25℃, 1 素子当たりの規格値<br>per diode                                                                 |                           |                      | 300      |         |         | A <sup>2</sup> s |
| 絶縁耐圧<br>Dielectric Strength               | V <sub>dis</sub> | 一括端子・ケース間, AC 1 分間印加<br>Terminals to Case, AC 1 minute                                                                     |                           |                      | 2.5      |         |         | kV               |
| 締め付けトルク<br>Mounting Torque                | TOR              | (推奨値 : 0.5 N・m)<br>(Recommended torque : 0.5 N・m)                                                                          |                           |                      | 0.8      |         |         | N・m              |

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c=25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

|                           |               |                                                                         |          |                           |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 順電圧<br>Forward Voltage    | $V_F$         | $I_F=12.5\text{A}$ , パルス測定, 1 素子当たりの規格値<br>Pulse measurement, per diode | MAX 1.05 | V                         |
| 逆電流<br>Reverse Current    | $I_R$         | $V_R=V_{RM}$ , パルス測定, 1 素子当たりの規格値<br>Pulse measurement, per diode       | MAX 10   | $\mu\text{A}$             |
| 熱抵抗<br>Thermal Resistance | $\theta_{jc}$ | 接合部・ケース間, フィン付き<br>Junction to Case, With heatsink                      | MAX 1    | $^\circ\text{C}/\text{W}$ |
|                           | $\theta_{jl}$ | 接合部・リード間, フィンなし<br>Junction to Lead, Without heatsink                   | MAX 5    |                           |
|                           | $\theta_{ja}$ | 接合部・周囲間, フィンなし<br>Junction to Ambient, Without heatsink                 | MAX 22   |                           |

# 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- \* Sine wave は 50Hz で測定しています。
- \* 50Hz sine wave is used for measurements.
- \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
Typical は統計的な実力を表しています。
- \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
Typical is a statistical average of the device's ability.